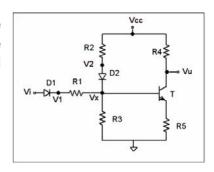
PROVA SCRITTA DI ELETTRONICA 10 GENNAIO 2008

1) Nel circuito in figura, i transistori possono essere descritti da un modello "a soglia", con V_{γ} =0.75 V e $V_{CE,sat}$ =0.2 V. Si determini la caratteristica statica di trasferimento $V_u(V_i)$, per 0< V_i < V_{cc} .



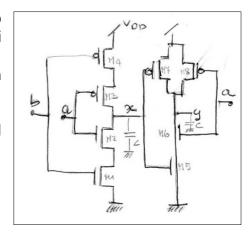
 $V_{cc} = 5 \text{ V}, \ \beta_F = 100, \ R_1 = 100 \ \Omega, \ R_2 = 10 \ k\Omega, \ R_3 = 2.5 \ k\Omega, \ R_4 = 2.5 \ k\Omega, \ R_5 = 500 \ \Omega.$

2) Nel circuito in figura, i transistori MOS sono caratterizzati dalle tensioni di soglia $V_{Tn}=|V_{Tnp}|=V_{T}$ e dai coefficienti β_n e β_p .

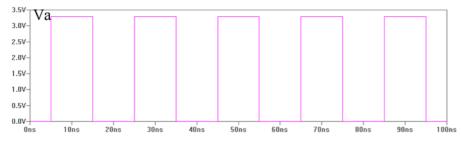
I segnali V_a e V_b abbiano l'andamento illustrato in figura.

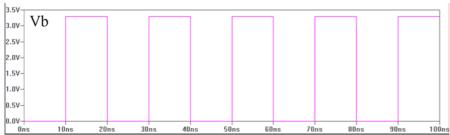
Si determini l'andamento di V_x e di V_y.

Si calcolino inoltre i tempi di propagazione relativi al segnale V_{ν} per ciascuna transizione.



 $V_{dd} = 3.3 \text{ V}, V_T = 0.4 \text{ V}, C=30 \text{ fF},$ $\beta_n=1 \text{ mA/V}^2, \beta_p=0.4 \text{ mA/V}^2.$





Esame di ELETTRONICA AB (mod. B): svolgere l'esercizio 1 (tempo disponibile 1h 15m). Esame di ELETTRONICA DEI SISTEMI DIGITALI A: l'esercizio 2 (tempo disponibile 1h 15m). Esame di FONDAMENTI DI ELETTRONICA A: svolgere gli esercizi 1 e 2 (tempo disponibile 2h).

- Indicare su ciascun foglio nome, cognome, data e numero di matricola
- Non usare penne o matite rosse

L'elaborato deve essere contenuto in un unico foglio (4 facciate) protocollo

Regione 1: Suppongo D1 OFF (se D1 OFF allora v1=vx, e D1 è OFF fintantoché vi-vx<v $_{\gamma}$).

Con D1 OFF, D2 deve essere ON. Infatti se D2 fosse OFF, vx=0 e v2=vcc, quindi la tensione ai capi di D2 sarebbe v2-vx=vcc>v $_{\gamma}$ e D2 non potrebbe essere OFF. Suppongo allora D1 OFF e D2 ON. Sotto queste condizioni verifico lo stato di T.

a) D1 OFF (per vi-vx<v $_{\gamma}$), D2 ON, T OFF(da verificare che vx<v $_{\gamma}$).

 $ir2=(vcc-vx-v_{\gamma})/r2$

ir3=vx/r3

Ma ir2=ir3, da cui si ricava che vx=0.85 V che è

 $>v_{\gamma}$, quindi T non può essere OFF.

Considero allora l'altro caso:

b) D1 OFF (per vi-vx<v $_{\gamma}$), D2 ON, T ON in AD (da verificare).

 $ir2=(vcc-vx-v_{\gamma})/r2$

 $ie1=(vx-v_y)/r5$

ir3=vx/r3

ic1=(vcc-vu)/r4

Ma ir2=ic1/ β_f +ir3 e ic1= β_f /(β_f +1)*ie1, da cui

si ricava vx = 0.846 V, vu = 4.524 V.

vce= vu-(vx- v_{γ})=4.428 V > vcesat, quindi è

verificato che T lavora in AD.

Si rimane in regione 1 fintantoché D1 rimane OFF, ovvero per vi-vx< v $_{\gamma}$, sse vi<1.596 V.

Regione 2: D1 ON, D2 ON, T ON in AD (da verificare), per vi>1.596 V.

 $ir1=(vi-v_{\gamma}-vx)/r1$ vx=-0.671+0.951 vi e $ir2=(vcc-vx-v_{\gamma})/r2$ vu=12.035 -4.706 vi.

ir3=vx/r3

 $ie1=(vx-v_y)/r5$ Si rimane in questa regione fintantochè T va SAT, ovvero per

ic1=(vcc-vu)/r4 quel valore di vi tale che vce=vcesat.

Ma ir1+ir2=ic1/ β_f +ir3 e vce= vu-(vx-v $_\gamma$)=12.035 -4.706 vi-(-0.671+0.951vi)+ v $_\gamma$

 $ic1=\beta_f/(\beta_f+1)*ie1$ =vcesat=0.2V.

Risolvendo si trova che: Quindi per vi>2.3436 V, T entra in saturazione.

Regione 2: per 1.596 V < vi < 2.3436V

Regione 3: D1 ON, D2 ON, T SAT.

ir3=vx/r3

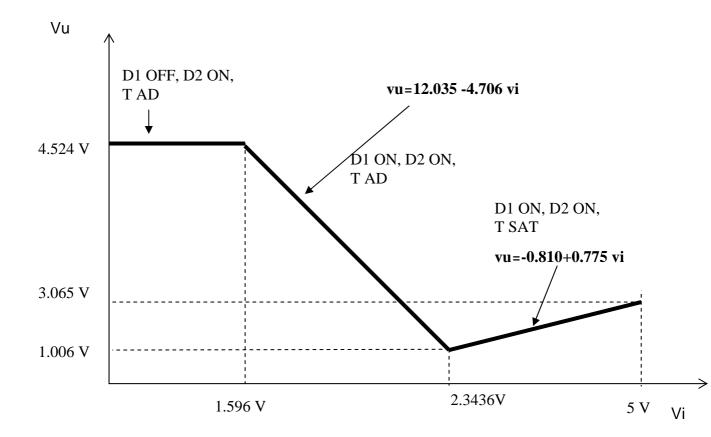
 $ie1 = (vx - v_v)/r5$

ic1=(vcc-vu)/r4

 $vx=(vu-vcesat+v_{\gamma})$

Regione 3: per 2.3436V < vi < 5V

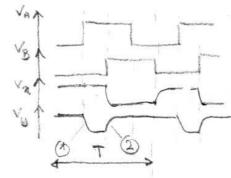
Di seguito si riporta la caratteristica statica di trasferimento.



Fs. 2 Il primo síadio è descritto dalla Tabella seguente:

a	6	R
L	L	H
L	H	elle impedence
H		alla impedenta
1	H	1

mente il secondo è un NAND CHOS siatico. Il segniale di uscita y ha quindi l'andonnento sequente.



Mel joriodo T sous quindi significative due Transitioni.

Quindi il to e la somme di tox (popagazione B->X, 2 milos in serve identico al precedente)